

★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 大野裕三 副委員長 国清辰也

幹事 黒田理人 幹事補佐 山口 直

日時 10月16日(木) 14:00~18:00

17日(金) 9:30~15:50

会場 東北大学未来科学技術共同研究センター未来情報産業研究館 5F (仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-10. <http://www.fff.niche.tohoku.ac.jp/contactus.html> TEL [022] 795-3977 黒田理人)

議題 プロセス科学と新プロセス技術

16日

1. [招待講演] IGBT の性能向上と現在の状況 寺島知秀 (三菱電機)
2. シリコン表面原子オーダー平坦化技術の STI プロセス工程への導入
○後藤哲也・黒田理人・赤川直矢・諏訪智之・寺本章伸・李 翔・小原俊樹・木本大幾・須川成利・大見忠弘 (東北大)・熊谷勇喜・鎌田 浩・渋谷勝彦 (ラピスセミ宮城)
3. 開放型熱処理装置を用いた Si 表面平坦化プロセスの検討 ○工藤聡也・大見俊一郎 (東工大)
4. Electrical characteristics of as-deposited HfN gate insulator formed by ECR plasma sputtering
○Nithi Atthi・Shun-ichiro Ohmi (Tokyo Inst. of Tech.)
5. [招待講演] イメージセンサーデバイスにおけるイオン注入 川崎洋司 (SEN)
6. [依頼講演] 3D 構造体への不純物層形成技術
○上田博一・岡 正浩・杉本靖広・小林勇気・野沢俊久・川上 聡 (東京エレクトロン)

17 日午前

1. Electronic Multinary Computing—Exemplified by 2-byte Arithmetic Addition of Base-10 Data—
Jaime Arago (LMC RD)
2. ラジカル窒化法により形成した $\text{Si}_3\text{N}_4/\text{Si}$ 界面に形成される組成遷移層に関する研究
○諏訪智之・寺本章伸・須川成利・大見忠弘 (東北大)
3. 角度分解 X 線光電子分光法による 4H-SiC の初期酸化過程の解明
○笹子知弥・山堀俊太・野平博司 (東京都市大)
4. MOCVD 法による Ge 及び $\text{Ge}_{1-x}\text{Sn}_x$ のエピタキシャル成長
○須田耕平・石原聖也・木嶋隆浩・澤本直美 (明大)・町田英明・石川真人・須藤 弘 (気相成長)・大下祥雄 (豊田工大)・小椋厚志 (明大)

17 日午後

5. [招待講演] 電子捕獲履歴現象を利用したナノスケール MOSFET における多値ランダムテレグラフノイズの解析
土屋敏章 (島根大)
6. MOSFET におけるランダムテレグラフノイズを引き起こすトラップ密度の解析に関する研究
○小原俊樹・寺本章伸・黒田理人・米澤彰浩・後藤哲也・諏訪智之・須川成利・大見忠弘 (東北大)
7. [招待講演] 超低電圧 0.4 V 動作 SOTB-CMOS 回路のゲート遅延ばらつきを抑制する基板バイアス制御技術
○横山秀樹・山本芳樹・尾田秀一・蒲原史朗・杉井信之・山口泰男 (LEAP)・石橋孝一郎 (電通大)・水谷朋子・平本俊郎 (東大)
8. 積層型 NAND MRAM の設計法 ○渡辺重佳 (湘南工科大)・玉井翔人 (大井電気)

☆SDM 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

11月6日(木), 7日(金) 機械振興会館 [締切済] テーマ: プロセス・デバイス・回路シミュレーション及び一般

【問合先】

黒田理人 (東北大)

TEL [022] 795-4833, FAX [022] 795-4834

E-mail: kuroda@fff.niche.tohoku.ac.jp